

ICS 77.150.99
CCS H 62



中华人民共和国国家标准

GB/T 10117—2021

代替 GB/T 10117—2009

高 纯 锑

High purity antimonium

2021-12-31 发布

2022-07-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 10117—2009《高纯铈》，与 GB/T 10117—2009 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了适用范围(见第 1 章,2009 年版的第 1 章)；
- b) 更改了化学成分中杂质元素 As、Au、Pb 的要求,增加了 B、Na、Al、Ca、Ga、Sn 杂质含量的要求(见 5.1,2009 年版的 3.2)；
- c) 增加了关于 Sb 含量、杂质含量总和的说明(见表 1)；
- d) 更改了外观质量的要求(见 5.2,2009 年版的 3.3)；
- e) 更改了试验方法的内容(见第 6 章,2009 年版的第 4 章)；
- f) 更改了检查和验收的内容(见 7.1,2009 年版的 5.1)；
- g) 更改了组批的规定(见 7.2,2009 年版的 5.2)；
- h) 增加了检验项目的内容(见 7.3)；
- i) 更改了取样、制样的要求(见 7.4,2009 年版的 5.3)；
- j) 增加了化学成分检验结果数值修约与判定的要求(见 7.5.1)；
- k) 更改了外观质量的检验结果判定(见 7.5.3,2009 年版的 5.4)；
- l) 更改了标志的内容(见 8.1,2009 年版的 6.2)；
- m) 删除了具体包装规格的要求(见 2009 年版的 6.1.1)；
- n) 删除了说明事项(见 2009 年版的 6.5)；
- o) 更改了随行文件的内容(见 8.5,2009 年版的 6.6)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC 203)与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会(SAC/TC 203/SC 2)共同提出并归口。

本文件起草单位：峨眉山市峨半高纯材料有限公司、峨嵋半导体材料研究所、广东先导稀材股份有限公司、有研国晶辉新材料有限公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、江苏秦烯新材料有限公司。

本文件主要起草人：张程、朱君、黎亚文、雷聪、曾洪、肖伟微、李强、张胜、乐卫华、黄文文、柴晨、普世坤、何建军。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 1988 年首次发布为 GB/T 10117—1988,2009 年第一次修订；
- 本次为第二次修订。